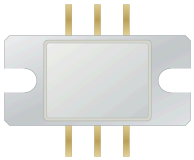
2000–6000 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (標準値)

LCT-2000-6000-PO45p51T · 2000–6000 MHz · GaN 内部整合型パワートランジスタ.



RF 電気特性表の規定値: 参考出力電力 45.51 dBm (標準値); 電力利得 19.51 dB (標準値); ドレイン効率 39.82 % (標準値) @ 6000 MHz. RF 測定条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm.

MH_400F6BA

6000 MHz におけるアプリケーション回路の代表参考値。

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 × 2.49 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	2000	-	6000	MHz
参考出力電力 [1]	-	-	45.51	-	dBm
電力利得 [1]	-	-	19.51	-	dB
ドレイン効率 [1]	ηD	-	39.82	-	%

[1] f = 6000 MHz

DC バイアスと電流

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン動作電圧	-	-	-	-	28	V
ドレイン静止電流	-	-	-	-	1.3	A
ゲートしきい値電圧 [1]	-	-4	-2.8	-1	-	V
静止ゲート・バイアス [2]	-	-	-2.6	-	-	V
ドレイン・ソース間降伏電圧 [3]	-	90	-	-	-	V
ドレイン・ソース間漏れ電流 [4]	-	-	-	0.0104	-	A

[1] VDS = 28 V; ID = 10.4 mA
[2] VDS = 28 V; ID = 1300 mA
[3] VGS = -10 V; ID = 10.4 mA
[4] VGS = -10 V; VDS = 90 V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	30	V
ゲート・バイアス下限	-	-10	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	-	-	-	225	°C
最大ゲート・バイアス	-	-	-	2	V
最大ゲート順方向電流	-	-	-	0.0104	A

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	18.03 × 8.7 × 2.49	mm

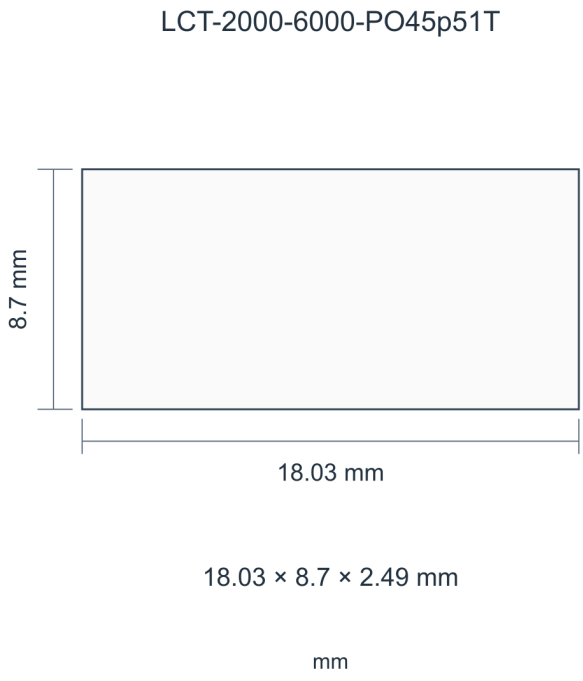
現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

実装上の注意

MH_400F6BA 6000 MHz におけるアプリケーション回路の代表参考値。

外形寸法図

一部の寸法を mm で示した参考図です。取り付けには完全な取付図を参照してください。



文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。